

## CV

### ნუგზარ დოლიძე

#### პირადი ინფორმაცია:

1. პ/ნ:01008009158,
2. სქესი: მამრობითი,
3. დაბადების თარიღი: 16.06.1942,
4. მოქალაქეობა: საქართველო,
5. ელ.ფოსტა: [nugzardolidze@gmail.com](mailto:nugzardolidze@gmail.com),
6. მობილურის ნომერი: 555223593,
7. მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძისპრ.24/21

#### განათლება:

1. ფიზ.მათ. მეცნ.დოქტორი (ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ, 2001წ),
2. ფიზ.მათ. მეცნ.კანდიდატი (საქ.სსრ მეცნ. აკად. ფიზიკის ინსტიტუტი,1979წ),
3. ფიზიკოსი, მყარი სხეულების ფიზიკა (თსუ, ფიზიკის ფაკულტეტი, 1959 წ).

#### სამუშაო გამოცდილება:

1. მიკრო და ნანოელექტრონიკის ს/კ ინსტიტუტი, თბილისი, ლაბორატორიის ხელმძღვანელი 2012 წლიდან დღემდე;
2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი, 2002-2021 წწ;
3. ვაშინგტონის კორპორაცია “ლიქუიდ ლაით ინკ”-ის ფილიალი საქართველოში, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, 2007-2011 წწ;
4. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ფიზიკის ფაკ-ტი, რადიაციული ტექნოლოგიების ს/კ სექტორის გამგე, 1992-2007 წწ;
5. სსგ "მიონ"-ი, ელექტრონული მრეწველობის სამინისტრო, რადიაციული კვლევების განყოფილება, უფროსი მეცნიერ მუშაკიდან განყოფილების უფროსამდე, 1965-1992 წწ.

#### მეცნიერული ინტერესები:

1. მიკრო- და ნანოელექტრონიკა;
2. რადიაციული დეფექტები კრისტალებში;
3. რადიაციით და ფოტონებით სტიმულირებული პროცესები;
4. პერსპექტიული, დაბალტემპერატურული რადიაციულ-ფოტონური ტექნოლოგიები;
5. არატრადიციული ენერჯის წყაროები;
6. ფიზიკა მედიცინაში.

**სამეცნიერო პროდუქტიულობა, სტატია/მონოგრაფია/სახელმძღვანელო/პატენტი:**

1. 86 სამეცნიერო სტატია (სამეცნიერო ჟურნალებში ФТТ, ФТП, Technical Physics Letters, Phys. Status Solidi, J. Nanotechnology Perceptions, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, ж.Вопросы атомной науки и техники, Georgian Engeneering News, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, ასევე სამეცნიერო ნაშრომების კრებულებში: New Developments in Material Science, New Science publishers, Inc. New York, "Радиационные дефекты в полупроводниках", изд. БГУ им. Ленина, Минск, "Радиационная физика неметаллических кристаллов", изд. "Наукова думка", Киев, და სხვა.
2. 75 საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობა,
3. 10 სახელმძღვანელო - წიგნები (სტუ-ს გამომცემლობა 2010-2019 წწ).
4. 7 პატენტი (2 სსრკ-ის და 6 საქპატენტი).

**გრანტები, პროექტები:** 2 საერთაშორისო (ISTC) და 6 ადგილობრივი (რუსთაველის საზოგადოება), 1996-2019წწ

**ენების ცოდნა:** ქართული-მშობლიური, რუსული - სრულყოფილად, ინგლისური ლექსიკონის დახმარებით.

**კომპიუტერული ცოდნა:** Word, Exel, Power Point ets. - კარგად

## CV

### Nugzar Dolidze

#### Personal information

1. ID Number: 01008009158
2. Gender: Male
3. Date of birth: 16.06.1942
4. Citizenship: საქართველო (Georgia)
5. E-mail address: nuzardolidze@gmail.com
6. Call number: 555 223 593
7. Tbilisi Address: I.Chavchavadze ave.24/21

#### Education:

1. Doctor of Science Phys. and Math. (D.Sc.), (Iv.Javakhishvili Tbilisi State University საქართველო (Georgia), 2001)
2. Candidat of Science Phys. and Math. (Ph.D.), (Institute of Physics of Academy of Sciences of Geo.SSR 1979)
3. Physicist, Solid State Physics (Tbilisi State University, Department of physics, 1959)

#### Work experience:

1. Research Institute of Micro- and Nano Electronics, Tbilisi, Head of Laboratory, from 2012 Until Today;
2. Georgian Technical University, Tbilisi, Full Professor, 2002-2021;
3. "Liquid Light Inc.", USA. Representative Office in Georgia, Senior Scientist, 2007-2011;
4. Iv.Javakhishvili Tbilisi State University, Department of Physics, Sector of Radiation Technologies, Head of Sector, 1992-2007;
5. Scientifically-Production Association 'MION', Ministry of Electronics, Department of Radiation Researches, From Scientist – up to Head of Department, 1965-1992.

#### Research Interests:

1. Micro- and Nanoelectronics;
2. Radiation Defects in Crystals;
3. Radiation and Photon Stimulated Processes;
4. Promising, Low-Temperature Radiation-Photon Technologies;
5. Unconventional Energy Sources;
6. Physics in Medicine.

**Scientific Productivity:**

1. 86 Scientific Articles (in Scientific Journals - Physics of the Solid State (Russian), Semiconductor (Russian), Technical Physics Letters (Russian), Phys. Status Solidi, J. Nanotechnology Perceptions, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, J. Issues of Atomic Science and Technology (Russian), Georgian Engineering News, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, as well as, in Collections of Scientific Papers –“New Developments in Material Science, New Science publishers”, Inc. New York, “Radiation defects in Semiconductors” Minsk, “ Radiation Physics of Non-metallic Crystals”, Kiev, and others. (Publications from 1965- until today).
2. 75 Participation in Both International and Local Conferences.
3. 10 Student Textbooks (GTU Publishing House, 2010-2019)
4. 7 Patents (2 – USSR, 6 – Georgian “Saqpatenti”)

**Grants and projects:** 2 International (ISTC) and 6 Local (1996 – 1919)

**Languages:** Georgian – mother, Russian – perfectly, English - with the help of a dictionary

**Computer Skills:** Word, Exel, Power Point ets. -good

